BUNDECREPUBLIK
DEUTSCHLAND

© Offenlegungsschrift © DE 3447635 A1

(5) Int. Cl. 4: H 01 L 31/18. B 05 D 5/06

635 A 1



DEUTSCHES PATENTAMT 

 (1)
 Aktenzeichen:
 P 34 47 635.0

 (2)
 Anmeldetag:
 28. 12. 84

 (3)
 Offenlegungstag:
 18. 7. 85

(3) Unionsprioritāt: (2) (3) (3) 28.12.83 JP P246949/83

(7) Anmelder: Hitachi, Ltd., Tokio/Tokyo, JP

② Vertreter:

Bardehle, H., Dipl.-Ing., Pat.-Anw.; Pagenberg, J.,
Dr.jur., Rechtsanw.; Dost, W., Dipl.-Chem.
Dr.rer.nat.; Altenburg, U., Dipl.-Phys., Pat.-Anw.;
Frohwitter, B., Dipl.-Ing.; Gravenreuth Frhr. von, G.,
Dipl.-Ing.(FH), Rechtsanw., 8000 München

@ Erfinder:

Okunaka, Masaaki, Fijisawa, JP; Nakatani, Mitsuo, Yokohama, JP; Matsuyama, Haruhiko, Hiratsuka, JP; Yokono, Hitoshi, Fijisawa, JP; Isogai, Tokio, Katsuta, JP; Saitoh, Tadashi, Tokio/Tokyo, JP; Matsukuma, Kunihiro; Midorikawa, Sumiyuki, Hitachi, JP; Suzuki, Satoru, Yokohama, JP

Prūfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

(S) Verfahren zur Herstellung von Solarzellon

Verfahren zur Herstellung von Solarzellen, welches die Anwendung einer Zusammensetzung zur Bildung einer Anti-Reflexions-Beschichtung auf einer Seite einer Siliciumausgangsplatte, die einen p-n-Übergang enthält, das Aufbringen bzw. Aufdrucken einer Silberpaste auf vorbestimmten Flächen der Beschichtung und Hitzebehandlung der entstehenden Platte bei einer Temperatur von 400 bis 900°C zur Vervollständigung einer Anti-Reflexions-Beschichtung und eines Kontakts auf der lichtempfangenden Seite beinhaltet, dadurch charakterisiert, das die Zusammensetzung zur Bildung der Anti-Reflexions-Beschichtung als notwendige Bestandteile (a) wenigstens eine Verbindung ausgewählt aus den Metallkomplexen mit organischen Liganden, die durch die allgemeine Formel M(OR<sub>1</sub>)<sub>n</sub>(L)<sub>a-n</sub> dargestellt werden, wobei M ein Metall ausgewählt aus Zn, Al, Ga, In, Ti, Zr, Sn, V. Nb. Ta, Mo und W ist; R1 ist eine C1-C18-Alkylgruppe; L ist ein organischer Ligand, der eine nichthydrolysierbare Bindung mit dem Metallion hildet; a ist die Wertigkeit des Metalls M und n ist eine ganze Zahl gemäß der Bedingung 1 ≤ n < a. und hydrolytischen Kondensationsprodukten davon, dargestellt durch die allgemeine Formel

(OR1), 1M(L), -O-M(OR1), 1(L), -

(b) wenigstens eine Organozinnverbindung, und (c) ein Lösungsmittel enthält.

## BARDEHLE, PAGENBERG, DOST, ALTENBURG & PARTNER

RECHISANWALTE

JOCHEN PAGENBERG DA JUR LL M HARVARD

BERNHARD FROHWITTER DIPL ING

GÜNTER FRHR. V. GRAVENREUTH DIPL ING (FM)

5

RATENTANWALTE - EUROPEAN PATENT ATTORNEYS
HEINZ BARDEHLE DIRLING
WOLFGANG A. DOST DIRLICHEM
UDO W. ALTENBURG DIRLIPHYS

3447635

POSTFACH 860620, 8000 MUNCHEN 86 TELEFON (089) 980361 TELEX 522791 pad d CABLE: PADBÜRO MÜNCHEN BÜRO. GALILEIPLATZ 1, 8 MÜNCHEN 8

DATUM 28. Dezember 1984 A 5967 D/La/ln

patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von Solarzellen, das die Anwen-10 dung einer Zusammensetzung zur Bildung einer Anti-Reflexions-Beschichtung auf einer Seite eines Siliciumsubstrats, das einen p-n-Ubergang enthält, Aufbringen einer Silberpaste zur Kontaktbildung an vorbestimmten Flächen der Beschichtung und Hitzebehandlung der ent-15 stehenden Platte bei einer Temperatur von 400 bis 900 °C zur Vervollständigung einer Anti-Reflexions-Beschichtung und eines Kontakts auf der lichtempfangenden Seite beingekennzeichnet, haltet, dadurch daß die Zusammensetzung zur Bildung der Anti-Reflexions-20 Beschichtung als wesentliche Komponenten

1

5

10

30

(a) mindestens eine Verbindung aus der Gruppe, die Metallkömplexverbindungen, die organische Liganden enthalten und durch die allgemeine Formel (5) dargestellt werden

 $M(OR_1)_n(L)_{a-n}$  (5)

und hydrolytische Kondensationsprodukte der Verbindungen nach Formel (5), die durch die allgemeine Formel (6) dargestellt werden

$$(OR_1)_{n-1}M(L)_{a-n}O-M(OR_1)_{n-1}(L)_{a-n}$$
 (6)

- umfaßt, wobei M ein Metall, ausgewählt aus Zn, Al,

  Ga, In, Ti, Zr, Sn, V, Nb, Ta, Mo und W, OR₁ eine
  Alkoxylgruppe, R₁ eine C₁-C₁8 -Alkylgruppe, L ein
  organischer Ligand, der eine nicht hydrolysierbare
  Bindung mit dem Metallion bildet, a die Wertigkeit
  des Metalls M und n eine ganze Zahl ist, die die

  Bedingung 1≤ n < a erfüllt,
  - (b) mindestens eine Organozinnverbindung, und(c) ein Lösungsmittel
  - enthält.
- 25 2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der organische Ligand L ein β-Diketoanion, dargestellt durch die allgemeine Formel

R<sub>2</sub>COCHCOR<sub>3</sub> (2)

ist, wobei  $R_2$  und  $R_3$   $C_1$ - $C_{18}$  -Alkylgruppen sind.

 Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der organische Ligand ein Carboxylatanion, dargestellt durch die allgemeine Formel

R<sub>4</sub>COO

- ist, wobei R<sub>4</sub> eine C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-Alkylgruppe ist.
  - 4. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der organische Ligand L ein Dicarboxylatanion, dargestellt durch die allgemeine Formel

$$\Theta \qquad \Theta \\
OOCR_5COO \qquad (4)$$

ist, wobei  $R_5$  eine  $C_1$ - $C_{18}$ -Alkylgruppe oder eine  $C_2$ - $C_{10}$ -Alkengruppe ist.

- 5. Verfahren nach Anspruch 2, bei dem das B-Diketoanion

  CH<sub>3</sub>COCHCOCH<sub>3</sub> ist.
- 6. Verfahren nach Anspruch 3, bei dem das Carboxylatanion

  CH<sub>3</sub>COO oder C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>COO ist.
  - 7. Verfahren nach Anspruch 4, bei dem das Dicarboxylatanion OOCH=C(CH<sub>3</sub>)COO ist.
- 8. Verfahren nach einem der vorhergehenden
  Ansprüche, bei dem die Metallkomplexverbindung nach
  Formel (5) Ti(OC<sub>3</sub>H<sub>7</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COCHCOCH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>,
  Al(OC<sub>3</sub>H<sub>7</sub>)<sub>2</sub>(OCOC<sub>3</sub>H<sub>7</sub>), Zr(OC<sub>4</sub>H<sub>9</sub>)<sub>3</sub>(OCOC<sub>7</sub>H<sub>15</sub>) oder
  Ta(OC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>COCHCOOCH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> ist.
  - 9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche bei dem das hydrolytische Kondensationsprodukt die

hat.

5

1 10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Organozinnverbindung wenigstens eine Verbindung ausgewählt aus den Verbindungen, die durch folgende allgemeine Formeln dargestellt werden, ist:

5		(m. ) C= (O) (T <sub>1</sub> )	(7)
		(R <sub>6</sub> ) Sn (O) (L)	(8)
		(R <sub>6</sub> ) <sub>2</sub> SnX(L)	(9)
10	,	(R <sub>6</sub> ) SnX (L) <sub>2</sub>	(10)
		(R <sub>6</sub> ) <sub>3</sub> Sn(L)	(11)
		$(R_6)_3$ SnX	. (12)
	oder	$(R_6)_2^{Sn(L)}_2$ $(R_6)_3^{SnSn(R_6)}_3$	(13)

wobei R<sub>6</sub> eine C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-Alkylgruppe, L ein organischer Ligand, dargestellt durch die Formeln (2), (3), oder (4) und X ein Hydroxidion, Halogenidion oder Nitration ist.

- 11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche

  bei dem die Organozinnverbindung wenigstens eine Verbindung ausgewählt aus C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>SnO(CH<sub>3</sub>COCHCOCH<sub>3</sub>),

  CH<sub>3</sub>Sn(O)(OCOC<sub>7</sub>H<sub>15</sub>), (C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>)<sub>2</sub>Sn(OH)(CH<sub>3</sub>COCHCOOC<sub>3</sub>H<sub>7</sub>),

  (C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>)<sub>2</sub>Sn(OH)(OCOC<sub>7</sub>H<sub>15</sub>), C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>Sn(OH)(CH<sub>3</sub>COCHCOCH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>,

  CH<sub>3</sub>Sn(OH)(OCOC<sub>7</sub>H<sub>15</sub>)<sub>2</sub>, (C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>)<sub>2</sub>SnCl(CH<sub>3</sub>COCHCOCOOC<sub>3</sub>H<sub>7</sub>),

  (C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>)<sub>2</sub>Sn(NO<sub>3</sub>)(OCOC<sub>7</sub>H<sub>15</sub>), (CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Sn(OH)(NO<sub>3</sub>),

  C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>Sn(NO<sub>3</sub>)(CH<sub>3</sub>COCHCOC<sub>7</sub>H<sub>15</sub>)<sub>2</sub>, (CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>Sn(CH<sub>3</sub>COCHCOCH<sub>3</sub>),

  (CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Sn(OCOCH=CHCOO), (C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>)<sub>2</sub>Sn(OCOCH=CHCOOC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub> und

  (CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>SnSn(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub> ist.
  - 30 12. Verfahren nach Anspruch 11, bei dem

    C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>Sn(O) (CH<sub>3</sub>COCHCOCH<sub>3</sub>) durch Umsetzung von

    C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>Sn(O) (OH) mit CH<sub>3</sub>COCH<sub>2</sub>COCH<sub>3</sub> hergestellt wurde.
  - 13. Verfahren nach Anspruch 11, bei dem CH<sub>3</sub>Sn(O) (OCOC<sub>7</sub>H<sub>15</sub>)

    durch Umsetzung von CH<sub>3</sub>Sn(O) (OH) mit C<sub>7</sub>H<sub>15</sub>COOH hergestellt wurde.

- 5 15. Verfahren nach Anspruch 11, bei dem (CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Sn(OH) (OCOC<sub>3</sub>H<sub>7</sub>) durch Umsetzung von (CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Sn(O) mit C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>COOH hergestellt wurde.
- 16. Verfahren nach Anspruch 11, bei dem

  10 C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>Sn(OH) (CH<sub>3</sub>COCHCOCH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> durch Umsetzung von

  C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>Sn(O) (OH) mit CH<sub>3</sub>COCH<sub>2</sub>COCH<sub>3</sub> hergestellt wurde.
- 17. Verfahren nach Anspruch 11, bei dem

  CH<sub>3</sub>Sn(OH) (OCOC<sub>7</sub>H<sub>15</sub>) durch Umsetzung von CH<sub>3</sub>Sn(O) (OH)

  mit C<sub>7</sub>H<sub>15</sub>COOH hergestellt wurde.
- 18. Verfahren nach Anspruch 10, bei dem eine Verbindung, dargestellt durch die Formel (R<sub>6</sub>)Sn(O) (OH) oder (R<sub>6</sub>)<sub>2</sub>Sn(O) anstelle der Verbindung verwendet wird, die durch die Formeln (R<sub>6</sub>)Sn(O)(L), (R<sub>6</sub>)<sub>2</sub>SnX(L) oder (R<sub>6</sub>)SnX(L)<sub>2</sub> dargestellt wird.
- 19. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche bei dem das molare Mischungsverhältnis von wenigstens einer Verbindung ausgewählt aus Metallkomplexverbindungen, die organische Liganden enthalten, und den hydrolytischen Kondensationsprodukten davon zu wenigstens einer Organozinnverbindung von 1:0,05 bis zu 1:3,0 beträgt.

30

35

20. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche bei dem das Mischungsverhältnis der Summe von (a) wenigstens einer Verbindung ausgewählt aus den Metall-komplexverbindungen, die organische Liganden enthalten, und den hydrolytischen Kondensationsprodukten davon und (b) wenigstens einer Organozinnverbindung zu (c)

- dem Lösungsmittel von 5:95 bis zu 50:50, bezogen auf das Gewicht, beträgt.
- 21. Verfahren nach Anspruch 20, bei dem der Mischungsanteil des Lösungsmittels 60 bis 80 %, bezogen auf das Cewicht, beträgt.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche bei dem das Lösungsmittel die Metallkomplexverbindung,
   die organische Liganden enthält, das hydrolytische Kondensationsprodukt und die Organozinnverbindung löst.
- 23. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche bei dem das Lösungsmittel ein Alkohol wie Ethanol und Isopropanol, ein Ethylenglykolmonoalkylether oder eine Mischung dieser Verbindungen ist.
- Verfahren nach einem der vorhorgehenden Ansprüche bei dem die Aufbringung der Zusammensetzung durch eines der folgenden Verfahren durchgeführt wird: Schleudergußverfahren, Aufwalzheschichtung, Eintauchen, Sprühen, Siebdruck.
  - 25. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche bei dem die Silberpaste ein Silberpulver als Hauptkomponente und ein Pulver aus Ti, Mg oder Ni und eine Borsilikatglasmasse als zusätzliche Komponenten enthält.
  - 30 26. Solarzellen, die nach einem Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche erhalten wurden.

7.

HITACHI, LTD. Kanda Surugadai 4-chome Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 28. Dezember 1984

A 5967 D/La/ln

5

### Beschreibung

10

## Verfahren zur Herstellung von Solarzellen

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Solarzellen, und ist insbesondere auf ein Verfahren für die Herstellung einer Anti-Reflexions-Beschichtung auf einem Siliciumsubstrat, welches einen p-n-Übergang enthält, gerichtet.

20

Der Umwandlungs-Wirkungsgrad bzw. Wirkungsgrad von Solarzellen wird durch Bedeckung der lichtempfangenden Oberfläche des Substrats mit einer Anti-Reflexions-Beschichtung,
um Oberflächenreflexion von einfallendem Licht zu vermei-

- den, erhöht. Diese Anti-Reflexions-Beschichtung ist ein Metalloxidfilm mit einer Dicke von λ/4 n (λ: Wellenlänge des einfallenden Lichts; n: Brechungsindex des Metalloxidfilms) welcher auf der Vorderseite des Substrats gebildet ist. Der Metalloxidfilm wird zum Beispiel durch (a) Vakuum-
- 30 bedampfung, (b) Spritzen oder Sprühen, (c) chemische Bedampfung, oder (d) Beschichtung und Brennen des Metallkomplexes hergestellt. Von diesen Verfahren sind (a), (b), und (c) von geringer Produktivität, da ein Vakuumsystem für die Filmbildung verwendet wird, und alle Verfahren (a)
- 35 bis (d) erfordern, nach Bildung der Anti-Reflexions-Beschichtung auf der gesamten Fläche der lichtempfangenden

1 Seite des Substrats, die lokale Entfernung des Films durch Atzen und Bildung eines Kollektorkontakts auf der freigelegten Fläche.

5 Um diese Nachteile zu eliminieren, wurde ein Verfahren vorgeschlagen, das die Beschichtung eines Siliciumsubstrats, welches einen p-n-Ubergang enthält, mit einem Metallkomplex, Aufbringen bzw. Aufdrucken einer leitfähigen Silberpaste an vorher festgelegten Positionen der Beschichtung und die Hitzebehandlung des entstehenden Substrats zur gleichzeitigen Vervollständigung einer Anti-Reflexions-Beschichtung und eines Silberkontakts, wodurch der Kontakt des Silbers mit dem Siliciumsubstrat erreicht wird, beinhaltet (IEEE Photovoltaic Specialists Conference, Seiten 360-361 (1976)).

Es wurde jedoch gefunden, daß die nach diesem Verfahren hergestellten Solarzellen einen hohen Kontaktwiderstand
zwischen dem Silber und dem Siliciumsubstrat aufweisen und
hinsichtlich des Füllfaktors und des Wirkungsgrades nicht
zufriedenstellend sind.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zur Herstellung von Solarzellen zur Verfügung zu stellen, das die gleichzeitige Bildung einer Anti-Reflexions-Beschichtung und eines Kollektorkontakts durch Aufdrucken erlaubt und einen niedrigen Kontaktwiderstand zwischen dem Silber und dem Siliciumsubstrat ergibt.

30 Die beigefügte Figur zeigt ein Fließdiagramm einer Solarzellenproduktion nach dem erfindungsgemäßen Verfahren.

Die obige Aufgabe der Erfindung wird gelöst durch Beschichtung eines Siliciumsubstrats, welches einen p-n-Ubergang enthält, mit einer Zusammensetzung, die wenigstens einen Alkoxyl-Liganden enthaltenden Metallkomplex, wenigstens eine Organo1 zinn-Verbindung und Lösungsmittel als wesentliche Komponenten enthält, Trocknen der Beschichtung falls notwendig, Aufbringen oder Aufdrucken einer leitfähigen Silberpaste an vorher festgelegten Stellen, Trocknen des Druckes oder Produkts falls notwendig, und Hitzebehandlung des entstehenden Substrats bei einer Temperatur von 400 bis 900 °C.

Der Metall-Alkoxid-Komplex mit einer Alkoxylgruppe als

Ligand wird durch die allgemeine Formel M(OR<sub>1</sub>)<sub>n</sub>, dargestellt, wobei M ein Metallion und R<sub>1</sub> eine C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-Alkylgruppe darstellt (OR<sub>1</sub> ist eine C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-Alkoxylgruppe). Dieser Komplex wird durch Reaktion mit in Luft vorhandener
Feuchtigkeit leicht hydrolysiert, wie durch folgende

Gleichung (1) gezeigt, wodurch Beschichtungsfilme dieses
Komplexes gehärtet werden.

$$2M(OR_1)_n = \frac{H_2O}{-2R_1OH} (R_1O)_{n-1}M-O-M(OR_1)_{n-1}$$

Die Reaktion nach Gleichung (1) läuft jedoch zu weit, dadurch eine zu harte Beschichtung ergebend. Werden eine solche übermäßig gehärtete Beschichtung und eine darauf aufgebrachte oder aufdruckte Silberpaste gleichzeitig gebrannt, wird das Silber die Beschichtung, die aus der Hydrolyse von M(OR<sub>1</sub>) resultiert, kaum durchdringen. Demzufolge wurde gefunden, daß die entstehende Solarzelle keinen wesentlichen Kontakt des Silbers mit dem Silicium-

l substrat aufweist.

Um die Hydrolyse nach Gleichung (1) zu kontrollieren, wurde ein Teil der Alkoxylgruppen des Metallkomplexes durch 5 einen organischen Liganden ersetzt, der eine nichthydrolysierbare Bindung mit dem Metall bildet.

Für diesen Liganden sind B-Diketoanionen, Carboxylatanionen und Dicarboxylatanionen, dargestellt durch die folgenden 10 allgemeinen Formeln (2), (3) und (4), geeignet.

In diesen Formeln repräsentieren R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub> und R<sub>4</sub> C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-Alkylgruppen und R<sub>5</sub> repräsentiert eine C<sub>2</sub>-C<sub>10</sub>-Alkengruppe
oder eine C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-Alkylgruppe.
Geeignete ß-Diketoanionen, dargestellt durch Formel (2),
schließen zum Beispiel CH<sub>3</sub>COCHCOCH<sub>3</sub>, CH<sub>2</sub>COCHCOC<sub>4</sub>H<sub>9</sub>, und

25 CH<sub>3</sub>COCHCOOCH<sub>3</sub> ein.Geeignete Carboxylatanionen, dargestellt
durch Formel (3), schließen zum Beispiel CH<sub>3</sub>COO,
C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>COO, C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>COOCH=CHCOO und CH<sub>3</sub>CH(OH)CH<sub>2</sub>COO ein.
Geeignete Dicarboxylatanionen, dargestellt durch Formel (4),
schließen zum Beispiel OOCCH=C(CH<sub>3</sub>)COO ein.

Die aus dem Metallkomplex nach Formel (1) durch die teilweise Ersetzung der Alkoxylgruppen durch die obigen Liganden entstehenden Verbindungen werden durch die allgemeine Formel

$$M(OR_1)_n(L)_{a-n}$$
 ---- (5)

1 dargestellt, wobei M ein Metallion wie Zn, Al, Ga, In, Ti,
Zr, Sn, V, Nb, Ta, Mo oder W ist; R₁ ist eine C₁-C₁8-Alkylgruppe, L ist ein organischer Ligand, der eine nichthydrolysierbare Bindung mit dem Metallion bildet und wird spezieller durch die Formeln (2), (3) oder (4) wie oben dargestellt; a ist die Wertigkeit von M und n ist eine ganze
Zahl, die die Bedingung 1≤n < a erfüllt.</pre>

Geeignete Beispiele des Metallkomplexes nach Formel (5) 10 sind  $\text{Ti}(OC_3H_7)_2(CH_3COCHCOCH_3)_2$ ,  $\text{Al}(OC_3H_7)_2(OCOC_3H_7)$ ,  $\text{Zr}(OC_4H_9)_3(OCOC_7H_{15})$ ,  $\text{Ta}(OC_2H_5)_3(C_2H_5COCHCOCH_3)_2$ . Von diesen Verbindungen wird  $\text{Ti}(OC_3H_7)_2(CH_3COCHCOCH_3)_2$  bevorzugt.

15 Hydrolytische Kondensationsprodukte der durch Formel (5) repräsentierten Verbindungen können auch verwendet werden. Diese Kondensationsprodukte werden durch die allgemeine Formel

20 
$$(OR_1)_{n-1}M(L)_{a-n}-O-M(OR_1)_{n-1}(L)_{a-n}$$
 ---- (6)

repräsentiert, wobei M, R<sub>1</sub>, L, a und n die gleichen Festewie in Formel (5) sind. Ein typisches Beispiel für die Verbindungen, die durch Formel (6) dargestellt werden, ist die Verbindung mit der folgenden Struktur:

30 
$$C_3^{H_7}$$
  $OC_3^{H_7}$   $OC_3^{H_7}$   $OC_3^{H_7}$   $OC_3^{H_7}$   $OC_3^{H_7}$   $OC_3^{H_7}$   $OC_3^{H_7}$   $OC_3^{H_7}$ 

1 Der Kontaktwiderstand, der bei der Herstellung von Solarzellen durch Bildung von Beschichtungen aus Verbindungen, die durch die Formeln (5) oder (6) dargestellt werden, und Aufbringen oder Aufdrucken eines Kontaktmusters mit einer

5 leitfähigen Silberpaste, gefolgt von einer Hitzebehandlung, entstand, betrug jedoch bis zu etwa  $0.3\,\Omega\,\mathrm{cm}^2$ .

Es wurde aber gefunden, daß dieser Kontaktwiderstand durch Verwendung mindestens einer Verbindung, ausgewählt aus den 10 Verbindungen nach Formel (5) oder (6) und mindestens einer Verbindung, ausgewählt aus Organozinnverbindungen, die durch die folgenden allgemeinen Formeln (7) bis (13) dargestellt werden, gesenkt werden kann.

15 
$$(R_6) \operatorname{Sn}(0) (L)$$
 - - - - - (7)  $(R_6)_2 \operatorname{SnX}(L)$  - - - - - (8)  $(R_6)_3 \operatorname{SnX}(L)_2$  - - - - - (10)  $(R_6)_3 \operatorname{SnX}(L)_2$  - - - - - (11)  $(R_6)_2 \operatorname{Sn}(L)_2$  - - - - - (12)  $(R_6)_3 \operatorname{SnSn}(R_6)_3$  - - - - (13)

- In den Formeln (7) bis (13) ist R<sub>6</sub> eine C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-Alkylgruppe, L ist ein B-Diketoanion, dargestellt durch Formel (2), ein Carboxylatanion, dargestellt durch Formel (3), oder 1/2 eines Dicarboxylatanions, dargestellt durch Formel (4), und X ist ein Hydroxidion, Halogenidion oder Nitration.
- Typische Beispiele für die Organozinnverbindungen sind die folgenden:  $C_4H_9Sno(CH_3COCHCOCH_3)$ ,  $(C_4H_9)_2Sn(OH)(OCOC_7H_{15})$ ,  $(C_4H_9)_2Sn(OH)(OCOC_7H_{15})$ ,  $(C_4H_9)_2Sn(OH)(NO_3)$ ,  $C_4H_9Sn(NO_3)(CH_3COCHCOC_7H_{15})$ ,  $(CH_3)_2Sn(OH)(NO_3)$ ,  $(C_4H_9Sn(NO_3)(CH_3COCHCOC_7H_{15})_2$ ,  $(CH_3)_3Sn(CH_3COCHCOCH_3)$ ,  $(CH_3)_2Sn(OCOCH=CHCOO)$ ,  $(C_4H_9)_2Sn(OCOCH=CHCOOC_2H_5)_2$  und  $(CH_3)_3SnSn(CH_3)_3$ .

- 1 Insbesondere sind die Verbindungen nach den Formeln (7) bis (9) bevorzugt, da sie feinere und z\u00e4here Filme, ergeben.
- 5 Verfahren zur Synthese dieser Organozinnverbindungen sind nachstehend durch Gleichungen anwendbarer Reaktionen verdeutlicht.

Verbindungen nach Formel (7),  $R_6 Sn(0)$  (L):  $C_4 H_9 Sn(0)$  (OH) +  $CH_3 COCH_2 COCH_2$   $\longrightarrow C_4 H_9 Sn(0)$  (CH<sub>3</sub>COCHCOCH<sub>3</sub>) +  $H_2 O$   $CH_3 Sn(0)$  (OH) +  $C_7 H_1 SCOOH$  $\longrightarrow CH_3 Sn(0)$  (OCOC<sub>7</sub>H<sub>15</sub>) +  $H_2 O$ 

Verbindungen nach Formel (8),  $(R_6)_2 SnX(L)$ :  $(C_4H_9)_2 Sn(O) + CH_3 COCH_2 COOC_3H_7$   $\longrightarrow (C_4H_9)_2 Sn(OH) (CH_3 COCHCOOC_3H_7)$   $(CH_3)_2 Sn(O) + C_3H_7 COOH$   $\longrightarrow (CH_3)_2 Sn(OH) (OCOC_3H_7)$ 

Verbindungen nach Formel (9),  $(R_6) SnX(L)_2$ :  $C_4 H_9 Sn(O) (OH) + 2CH_3 COCH_2 COCH_3$   $C_4 H_9 Sn(OH) + 2C_7 H_1 COOH + H_2 O$   $CH_3 Sn(O) (OH) + 2C_7 H_1 COOH$   $CH_3 Sn(OH) (OCOC_7 H_15)_2 + H_2 O$ 

An Stelle der Verwendung einer isolierten Organozinnverbindung, dargestellt durch die Formeln  $(R_6)$ Sn(O) (L),  $(R_6)_2$ Sn(L) oder  $(R_6)$ Sn $(L)_2$  ist es auch möglich, die bei der Reaktion einer Verbindung der Formeln  $(R_6)$ Sn(OH) oder  $(R_6)_2$ Sn(O) mit einem B-Diketon oder mit einer Carbonsäure

1 in einem Lösungsmittel entstehende Mischung als solche mit dem Metallalkoxidkomplex nach Formel (5), M(OR<sub>1</sub>)<sub>n</sub>(L)<sub>a-n</sub> oder mit dem hydrolytischen Kondensationsprodukt davon zu mischen, und die entstehende Lösung zur Bildung der 5 Anti-Reflexions-Beschichtung zu verwenden.

Demgemäß enthält die für die Erfindung verwendete Zusammensetzung zur Bildung der Anti-Reflexions-Beschichtung wenigstens eine Verbindung, ausgewählt aus den Verbindun-10 gen nach Formeln (5) und (6), und mindestens eine Verbindung, ausgewählt aus den Organozinnverbindungen der Formeln (7) bis (13), und ein Lösungsmittel als wesentliche Komponenten.

- 15 Geeignete molare Mischungsverhältnisse von wenigstens einer Verbindung, ausgewählt aus Verbindungen der Formeln (5) und (6), zu wenigstens einer Verbindung, ausgewählt aus den Organozinnverbindungen nach Formeln (7) bis (13), betragen von 1:0,05 bis zu 1:3,0. Beträgt der Anteil der
- 20 Organozinnverbindung weniger als 0,05, wird nur eine geringe Wirkung bei der Erniedrigung des Kontaktwiderstandes erreicht, beträgt der Anteil mehr als 3,0, ist die Härte des entstehenden Films nicht ausreichend, um die leitfähige Silberpaste aufzubringen oder aufzudrucken, ohne den 25 Film anzugreifen beziehungsweise zu beschädigen (marring).

Geeignete Mischungsverhältnisse, bezogen auf das Gewicht, der Summe von wenigstens einer Verbindung, ausgewählt aus Verbindungen nach Formeln (5) und (6) und wenigstens einer Verbindung, ausgewählt aus Verbindungen der Formeln (7) bis (13), zum Lösungsmittel betragen von 5:95 bis zu 50:50. Beträgt der Gewichtsanteil des Lösungsmittels mehr als 95 %, ist der entstehende Film zu dünn, beträgt der Anteil weniger als 50 Gew.%, wird die Zusammensetzung zu viskos und ist schwierig aufzubringen. Lösungsmittelanteile von 60 bis 80 Gew.% geben am besten verarbeitbare Zu-

l sammensetzungen.

Für die Erfindung kann jegliches Lösungsmittel verwendet werden, das die Verbindung nach der Formel M(OR<sub>1</sub>)<sub>n</sub>(L)<sub>a-n</sub> oder das hydrolytische Kondensationsprodukt davon und die Organozinnverbindung löst. Bevorzugte Lösungsmittel sind jedoch Alkohole, wie Ethanol und Isopropanol und Ethylenglykol-monoalkylether, die die Bildung gleichmäßiger Beschichtungen erleichtern. Zwei oder mehrere dieser Lösungsmittel können in Kombination verwendet werden.

Die Anwendung der Zusammensetzung, um die Anti-Reflexions-Beschichtung auf dem Substrat zu bilden, wird durch Schleudergußbeschichtung (spinner coating), Aufwalzbe-

- 15 schichtung (roll coating), Eintauchen, Sprühen oder Besprühen, Sieb- bzw. Filmdruck (screen printing) oder andere Verfahren durchgeführt. Im Falle von Siebdruck kann ein Verdicker wie Nitrocellulose, Poly (methylmetacrylat) oder dergleichen zur Zusammensetzung für die Bildung einer
- 20 Anti-Reflexions-Beschichtung zugegeben werden, um die Viskosität auf einen für den Sieb- bzw. Filmdruck geeigneten Wert einzustellen.

Die Silberpaste zur Kontaktbildung enthält vorzugsweise ein 25 Silberpulver als Hauptkomponente und ein Ti-, Mg- oder Ni-Pulver und eine Blei-Bor-Silikatglasmasse als zusätzliche Komponenten.

Die Hitzebehandlung der Beschichtungen wird vorzugsweise bei 30 einer Temperatur im Bereich von 400 bis 900°C durchgeführt. Temperaturen unter 400°C für die Behandlung resultieren in ungenügender Zersetzung der organischen Komponenten im Beschichtungsfilm und in der Silberpaste, während Temperaturen über 900°C zu einer übermäßigen Diffusion von Silber in 35 das Silicium führen, was häufig Fehlerstellen (leakages) verursachen kann.

1 Die Erfindung wird nun im Detail unter Bezugnahme auf die folgenden Beispiele erläutert.

#### Beispiel 1

- 5 Eine n -Schicht (spezifischer Widerstand etwa  $1.5 \times 10^{-3} \Omega$  cm) von 0.3 bis 0.5 µm Tiefe wurde durch ein Ionenimplantationsverfahren in einer Seite eines Siliciumsubstrats 1 vom p-Typ (eine kreisförmige dünne Scheibe (waser) von 7,6 cm Durchmesser mit einem spezifischen Widerstand von
- 10 1 bis  $5\,\Omega\text{cm}$ ) und eine p<sup>+</sup>-Schicht von 1 bis 2  $\mu\text{m}$  Tiefe wurde durch das Aluminiumdiffusionsverfahren in der gegenüberliegenden Seite des Substrats gebildet. Solche Siliciumsubstrate wurden als übergangsbildende Siliciumsubstrate für Solarzellen verwendet.
- 15 Die in Tabelle 1 gezeigten Zusammensetzungen wurden als Beschichtungsmaterialen für Anti-Reflexions-Beschichtungen hergestellt.
- 20 Diese Zusammensetzungen wurden mehrmals auf den n<sup>+</sup>-Schichtseiten der Silicium substrate durch ein Schleudergußverfahren (spinner coating) aufgebracht. Die Rotationsgeschwindigkeit betrug 3000 min 1 und die Zeit 60 Sekunden. Anschließend wurden die Beschichtungen 2 jeweils bei etwa 100°C 25 10 Minuten getrocknet.

Eine Silberpaste zur Kontaktbildung wurde auf die folgende Weise hergestellt: eine viskose Lösung von Ethylcellulose (10 Gewichtsteile) in  $\alpha$ -Terpineol (90 Gewichts-30 teile) wurde zu einer Mischung, bestehend aus einem Silberpulver (10 g) mit einem Teilchendurchmesser von nicht mehr als 1  $\mu$ m, einem Ti-Pulver (1 g ), welches zur Stabilisierung oberflächenbehandelt war, und einer Glasmasse vom PbO-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub>-Typ unter kräftigem Rühren zugegeben, wo-35 durch sich die gewünschte Paste mit einer Viskosität von etwa 200 Poise (Schergeschwindigkeit 100/Sekunde) ergab.

1 Diese Paste wurde durch Siebdruck bzw. Filmdruck auf die Anti-Reflexionsbeschichtung, die die n<sup>+</sup>-Schicht jedes Siliciumsubstrats bedeckt, zur Bildung einer kammähnlichen Struktur (pattern) 3 und zur Bildung einer anderen Struktur 4
5 auf die p<sup>+</sup>-Schicht jedes Substrats zur Bedeckung der gesamten Oberfläche aufgebracht. Die aufgebrachte Paste wurde bei 150°C 10 Minuten getrocknet. Dann wurden die entstehenden Substrate 10 Minuten bei 600°C in einer Stickstoffatmosphäre, die 50 ppm Sauerstoff enthielt, gebrannt, um die 10 gebrannten Strukturen 5, 6 und 7 zu bilden, die den Strukturen 3 bzw. 4 bzw. der Beschichtung 2 entsprechen.

Die so hergestellten Solarzellen wurden auf Strom-Spannungseigenschaft (I-V-Eigenschaft), Kurzschlußstromdichte, 15 Öffnungsspannung, Füllfaktor und Wirkungsgrad untersucht.

Der Kontaktwiderstand zwischen Silber und der n°-Schicht wurde ebenfalls gemessen. Jede der Zellen zeigte eine Kurzschlußstromdichte von etwa 28mA/cm² und eine Öffnungs20 spannung von etwa 0,59 V.

Wie aus Tabelle 1 hervorgeht, ergaben die Zusammensetzungen der Proben Nr. 1 bis 17 so gute Eigenschaften, wie einen Kontaktwiderstand von 0,03 bis 0,04  $\Omega$  cm<sup>2</sup>, einen Füllfaktor

- 25 von 0,78 bis 0,81 und Wirkungsgrade von 13,3 bis 13,6 %, die gegenüber den Proben Nr. 18 bis 21, die durch Verwendung bekannter Zusammensetzungen erhalten wurden, stark verbessert sind. Die Proben Nr. 6 bis 16, d. h., Solarzellen, die durch Verwendung von Organozinnverbindungen
- 30 der Formeln  $(R_6)$ Sn(O)(L) oder  $(R_6)_2$ Sn(X)(L) hergestellt wurden, waren besonders hinsichtlich der Feinheit der Struktur bzw. des Aufbaus der gebildeten Anti-Reflexions-Beschichtung überlegen.

	I was the second of the second					
Probe	Alkoxyl-enthaltender Metallkomplex	(A)				
Nr.	(Gewichtsteile)					
1	<u>'</u>					
2						
3						
4						
5	1					
6	Ti(OC <sub>3</sub> H <sub>7</sub> ) <sub>2</sub> (CH <sub>3</sub> COCHCOCH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	(40)				
7						
8	_					
9						
10						
11	· ·					
12						
13	A1 (OC3H7) 2 (OCOC3H7)	(30)				
14	Zr (OC4H9) 3 (OCOC7H15)	(50)				
15	та (OC <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) 3 (C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> COCHCOOCH <sub>3</sub> ) 2	(50)				
16	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> O Ti O O O O O O O O O O O O O O O O O	(50)				
17	Ti(OC <sub>3</sub> H <sub>7</sub> ) <sub>2</sub> (CH <sub>3</sub> COCHCOCH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Al(OC <sub>3</sub> H <sub>7</sub> ) <sub>2</sub> (OCOC <sub>3</sub> H <sub>7</sub> )	(20) (15)				
18	Ti(OC3H7)2(CH3COCHCOCH3)2	(40)				
19	A1 (OC3H7) 2 (OCOC3H7)	(30)				
20	Zr (OC4H9) 3 (OCOC7H15) (50)					
21	Ta (OC <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) 3 (C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> COCHCOOCH <sub>3</sub> ) 2 (50)					

Anmerkung: Ethylenglykolmoncethylether (100 Gew.-Teile)

wurde als Lösungsmittel verwendet

- Forts. -

## TABELLE 1 (Forts.)

•				
		Molver-		
Organozinnverbindung	į	hältnis	į .	
(Gewichtsteile)		$(\frac{B}{A})$		
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			<u> </u>	
(C4H9) 3SnCl	(18)	0.50	<u>L</u>	
(C4H9) 3Sn (OCOC3H7)	(21)	0.51		
(CH3) 2Sn (OCOCH=CHCOOC2H5) 2	(24)	0.50		
(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> SnCl <sub>2</sub>	(12)	0.55		
(CH3) 3Sn (CH3COCHCOCH3)	(14)	0.48		
(CH3) 2Sn (OH) (NO3)	(13)	0.52		
CH3Sn(O) (CH3COCHCOCH3)	(14)	0.51		-
C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> Sn(0) (OCOC <sub>7</sub> H <sub>15</sub> )	(18)	0.51		_
(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Sn (OH) (CH <sub>3</sub> COCHCOCH <sub>3</sub> )	(15)	0.52		- -
(C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> ) 2Sn (OH) (С <sub>3</sub> H <sub>7</sub> COCHCOOCH <sub>3</sub> )	(21)	0.49		_
(C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> ) <sub>2</sub> Sn (OH) (OCOC <sub>7</sub> H <sub>15</sub> )	(22)	0.51		_
		0.50		_
		0.27	T	-
		0.50	1	_
		0.63		•
	٠.		1	-
	(16)	1		
C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> Sn(0)(CH <sub>3</sub> COCHCOCH <sub>3</sub> )	(10)			
		0.26		
		0.20		
	•			
•				
(21) (27) (10)	(10)	-	- -	-
(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Sn (OH) (NO <sub>3</sub> ) C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> Sn (O) (OCOC <sub>7</sub> H <sub>15</sub> )	(5)	0.38	.	
-3/5(-715.		-	$\dashv$	
			•	
keine		-		
			1	

TABELLE 1 (Forts.)

Cha	arakterist. Wert	e
Kontakt-		Wirkungs- grad
widerstand (Ωcm <sup>2</sup> )	Füllfaktor	(%)
0.03	0.80	13.5
0.04	0.79	13.3
0.03	0.81	13.6
0.03	0.81	13.6
0.03	0.80	13.5
0.04	0.80	13.5
0.03	0.81	13.6
0.03	0.81	13.6
0.03	0.80	13.5
0.04	0.78	13.3
0.03	0.81	13.6
0.03	0.81	13.6
0.03	0.81	13.6
0.03	0.80	13.5
0.03	0.81	13.6
0.03	0.81	13.6
0.03	0.80	13.5
0.31	0.49	8.6
0.30	0.47	8.3
0.38	0.53	8.9
0.35	0.51	8.7

- <del>15</del> - 21

Die in Tabelle 2 gezeigten Zusammensetzungen wurden aus Ti(OC<sub>3</sub>H<sub>7</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COCHCHCH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>Sn(O)(CH<sub>3</sub>COCHCOCH<sub>3</sub>) und Ethylenglykolmonoethylether hergestellt. Unter Verwendung dieser Zusammensetzungen wurden Solarzellen auf die gleiche Weise wie in Beispiel ¹ hergestellt. Die charakteristischen Werte dieser Zellen sind in Tabelle 2 gezeigt.

TABELLE 2

	··· ·· · · · · · · · · · · · · · · · ·	····	- · ·					:. 
charakteristische Werte	Wirkungs- grad (8)	8*6	10.8	13.6	13.5	13.6	13.5	13.5
	Füll- faktor	0.55	09.0	0.81	0.80	0.81	0.80	0.30
charakte	Kontakt- wider- stand ( $\Omega$ cm <sup>2</sup> )	0.20	0.11	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Molver-	hültnis (B/A) I	0.01	0.03	0.05	0.2	<b>-</b>	3	4
Angriff	(Marring) an Anti- Reflexions- beschichtunj	keiner	=	=	=	=	=	ı
1 Mischungsanteil Angriff	von C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> Sn(O)- (CH <sub>3</sub> COCHCOCH <sub>3</sub> ) (B) (Gewichtsteile)	(0.3)	(1.0)	(1.6)	(6.4)	(32)	(96)	(128)
Mischungsanteil	von Ti(OC <sub>3</sub> H <sub>7</sub> ) <sub>2</sub> - (CH <sub>3</sub> COCHCOCH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> (A) (Gewichtsteile)	(40)	(40)	(40)	(40)	(40)	(40)	(40)
Probe	Z	22	23	24	25	26	.27	28

Anmerkung: Ethylenglykolmonoethylether (100 Gewichtsteile) wurde als Lösungsmittel

verwendet.

Aus Tabelle 2 kann entnommen werden, daß der Kontaktwiderstand einen Sättigungswert erreicht, wenn das molare Verhältnis von C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>Sn(O) (CH<sub>3</sub>COCHCOCH<sub>3</sub>) zu
Ti(OC<sub>3</sub>H<sub>7</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COCHCOCH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> unter 0.05 liegt. Im Gegensatz

dazu, wurde ein Eindruck der Siebdruck- bzw. Filmdruckplatte

5 dazu, wurde ein Eindruck der Siebdruck- bzw. Filmdruckplatte in der Anti-Reflexions-Beschichtung unter dem Mikroskop beobachtet, wenn as Verhältnis über 3,0 erhöht wurde.

### Beispiel 3 🔗

Eine Zusammensetzung wurde gebildet aus

Ti(OC<sub>3</sub>H<sub>7</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COCHCOCH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (40 Gewichtsteile),

C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>Sn(O)(CH<sub>3</sub>COCHCOCH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (32 Gewichtsteile) und Ethylenglykolmonoethylether (30 Gewichtsteile) und auf ein

Siliciumsubstrat aufgebracht. Es konnte jedoch sogar bei

so hohen Rotationsgeschwindigkeiten wie 8000min 1 keine
gleichmäßige Beschichtung erreicht werden, da die Zusammensetzung zu viskos war.

#### Beispiel 4

Eine Zusammensetzung wurde hergestellt aus

Ti(OC<sub>3</sub>H<sub>7</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COCHCOCH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (40 Gewichtsteile),

C4H<sub>9</sub>Sn(O)(CH<sub>3</sub>COCHCOCH<sub>3</sub>) (32 Gewichtsteile) und Ethylenglykolmonoethylether (1300 Gewichtsteile) und auf ein

Siliciumsubstrat aufgebracht. Es konnte jedoch sogar bei

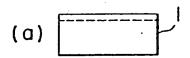
so niedrigen Rotationsgeschwindigkeiten wie 500min keine
Anti-Reflexions-Beschichtung mit der notwendigen Dicke von
700 Å (70 nm) oder mehr erhalten werden.

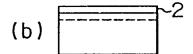
30

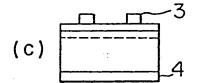
Figur:

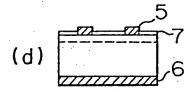
65.

Nummer: Int. Cl.<sup>3</sup>: Anmeldetag: Offenlegungstag: 34 47 635 H 01 L 31/18 28. Dezember 1994 18. Juli 1985









# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

D BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
OTHER:	-

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.